

2SC3272

三重拡散プレーナ形 NPN シリコントランジスタ
中電力増幅用/Medium Power Amp.

Triple Diffused Planar NPN Silicon Transistor

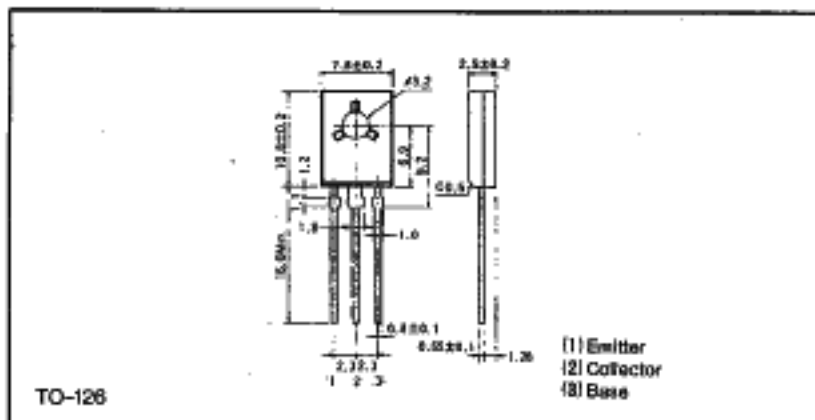
● 特長

- 1) 高耐圧である ($BV_{CEO}=300V$)。
- 2) コレクタ出力容量が小さい。
- 3) カラーテレビのクロマ出力、映像信号増幅に最適。

● Features

- 1) High breakdown voltage:
 $BV_{CEO}=300V$
- 2) Small collector output capacitance.
- 3) Ideal for use in color TV chroma output and video signal amplification.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	300	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	300	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	5	W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)
		1.2	W ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)
接合部温度	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

● 電氣的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CE0}	300	—	—	V	$I_C = 100\mu A$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	300	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	500	nA	$V_{CB} = 200V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	500	nA	$V_{EB} = 4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	2.0	V	$I_C/I_E = 50mA/5mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	39	—	180	—	$V_{CE}/I_C = 10V/10mA$
利得帯域幅積	f_T	50	100	—	MHz	$V_{CE} = 30V, I_E = -10mA$
出力容量	C_{ob}	—	3.0	—	pF	$V_{CB} = 30V, I_E = 0A, f = 1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	M	N	P
hFE	39~82	56~120	82~180

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:選擇標準品)

Type	hFE	包装名	バルク
		記号	
		基本発注単位(個)	1 000
29C3272	MNP		○

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

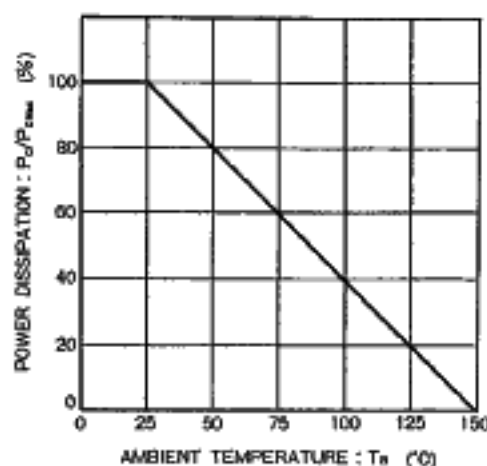


Fig. 1 電力軽減曲線

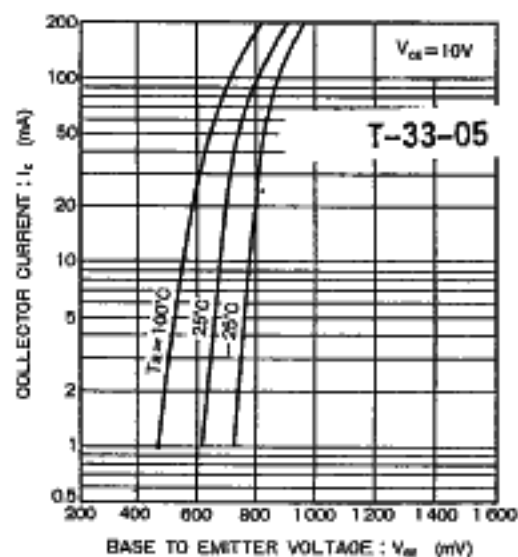


Fig. 2 エミッタ接地伝達静特性

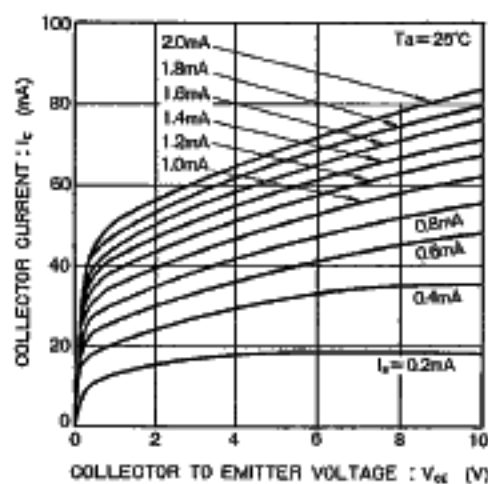


Fig. 3 エミッタ接地出力静特性 (I)

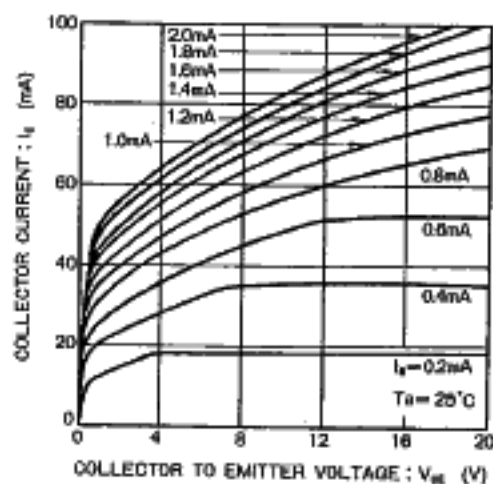


Fig. 4 エミッタ接地出力静特性 (II)

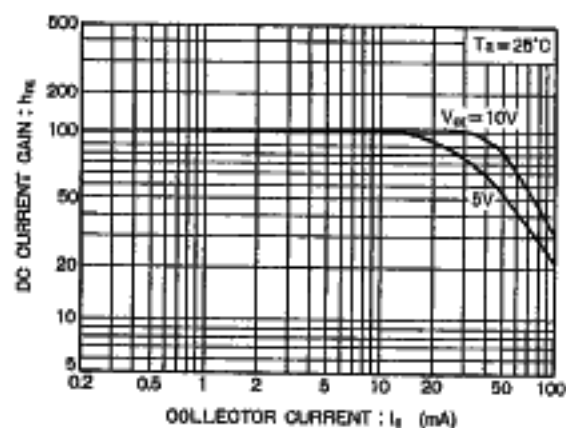


Fig. 5 直流電流増幅率—コレクタ電流特性 (I)

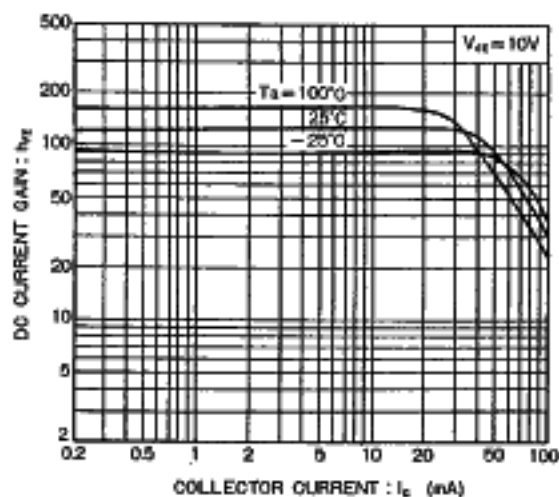


Fig. 6 直流電流増幅率—コレクタ電流特性 (II)

トランジスタ

2SCタイプ

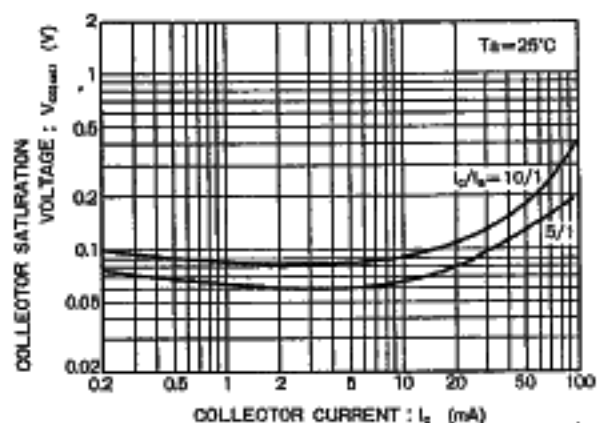


Fig. 7 コレクタ・エミッタ間飽和電圧—コレクタ電流特性

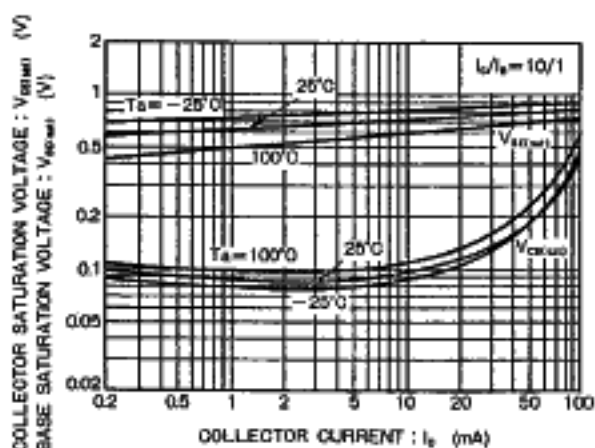


Fig. 8 コレクタ・エミッタ間飽和電圧—コレクタ電流特性
ベース・エミッタ間飽和電圧

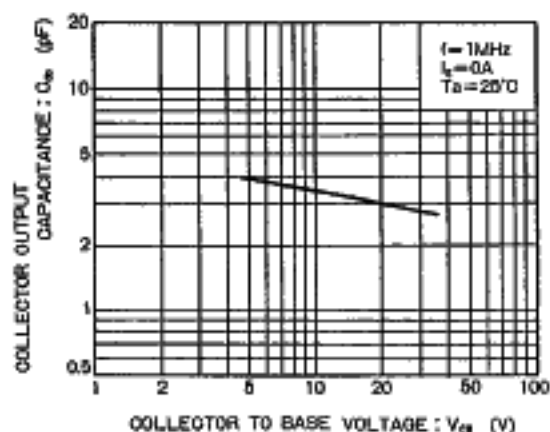


Fig. 9 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース間電圧特性

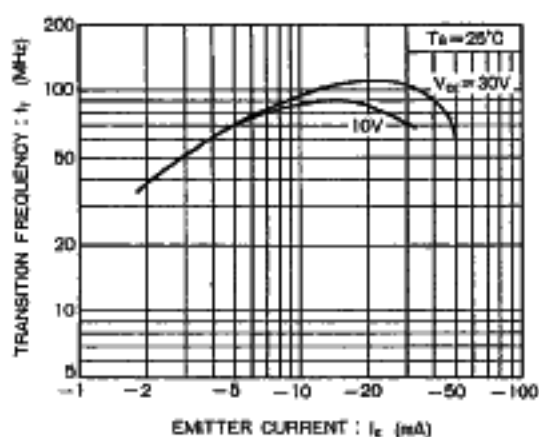


Fig. 10 利得帯域積—エミッタ電流特性